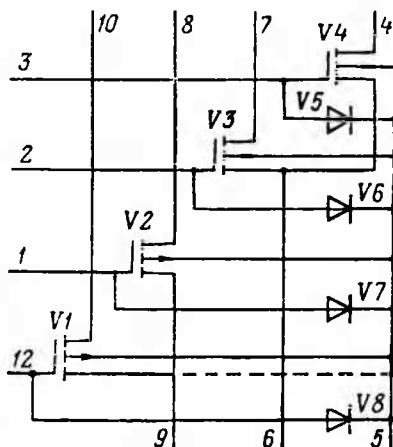


190КТ2, К190КТ2

Микросхемы выполнены на МДП-транзисторах с индуцированным каналом p -типа. Предназначены для коммутации электрических сигналов. Конструктивно оформлены в корпусе типа 301.12-1 (серия 190) или в прямоугольном пластмассовом типа 201.14-1 (серия К190).

Микросхемы используются как четырехканальный коммутатор.



Принципиальные схемы ИМС 190КТ2, К190КТ2

Параметры	Режим измерения	190КТ2
		К190КТ2
$U_{зи\text{ пор}}$, В	$U_{ип}=0$; $I_c=10$ мкА, $U_{си}=-5$ В	-6
$I_{з\text{ ут}}$, нА	$U_{зи}=-30$ В; $U_{си}=U_{ип}=0$	≤ 30
		≤ 50
$I_{с\text{ нач}}$, нА	$U_{ип}=U_{зи}=0$; $U_{си}=-25$ В	≤ 400
$I_{п}$, нА	$U_{ип}=25$ В	≤ 150
$R_{отк}$, Ом	$U_{зи}=-20$ В, $U_{ип}=0$; $I_c=1$ мА	≤ 50
$R_{отк}$, Ом	$U_{зи}=-10$ В; $U_{ип}=0$; $I_c=1$ мА	≤ 120
$C_{11и}$, пФ	$U_{си}=-15$ В; $U_{ип}=0$; $f=1$ МГц	≤ 24
$C_{12и}$, пФ	$U_{си}=-15$ В; $U_{ип}=0$; $f=1$ МГц	≤ 9
$C_{22и}$, пФ	$U_{си}=-15$ В; $U_{ип}=0$; $f=1$ МГц	15

¹ При температуре 25 ± 10 °С

Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации указаны в следующей таблице.

$U_{си}$, В	$U_{зи}$, В	$U_{зс}$, В	$U_{ип}$, В	$U_{зп}$, В	I_c , мА	$P_{рас\text{ макс}}$, мВт
-25	-30	-30	25	-30	10 ¹	200

¹ Для микросхемы 190КТ1, для ИМС 190КТ2 $I_{с\text{ макс}}=50$ мА.